

トランジスタ

T-33-13 2SC2415

2SC2415

シリコン NPN 三重拡散メサ形/Si NPN Triple Diffused Mesa

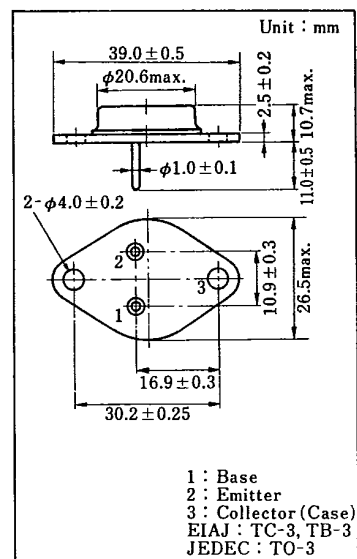
高速電力スイッチング用/High Speed Power Switching

■ 特徴/Features

- スイッチング速度が速い。/High speed switching
- ガラスパッシベーションによる高耐圧, 高信頼性。/
High voltage and high reliability realized by glass passivation

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	7	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	15	A
コレクタ電流	I _C	7	A
コレクタ損失(Tc=25 °C)	P _C	90	W
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	°C

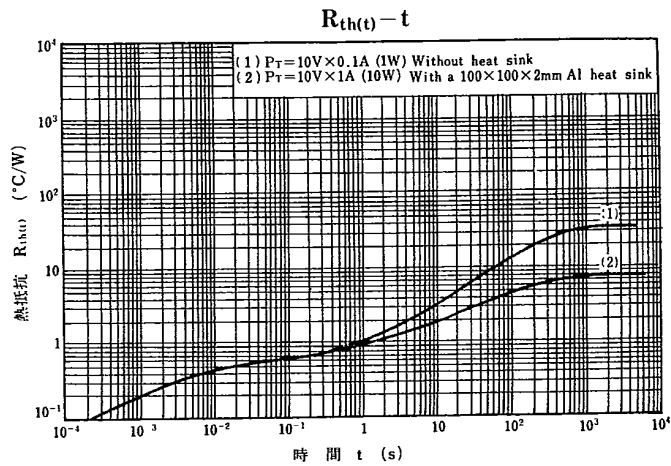
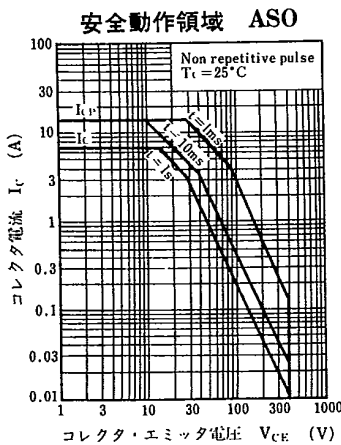
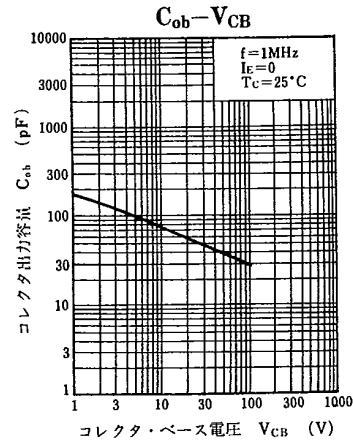
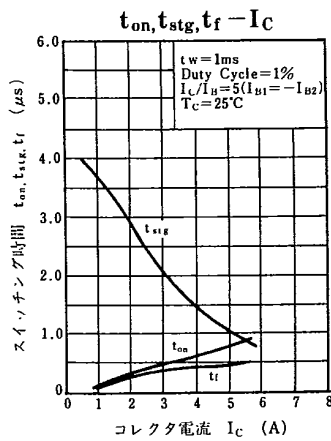
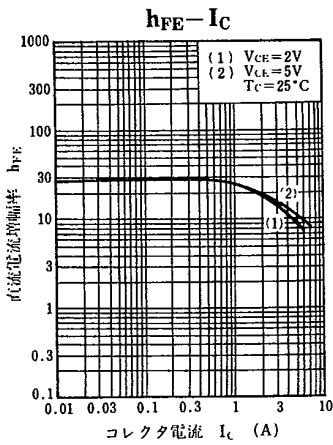
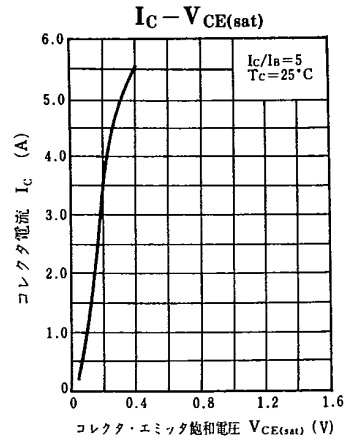
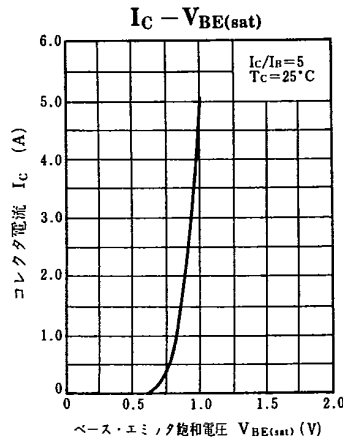
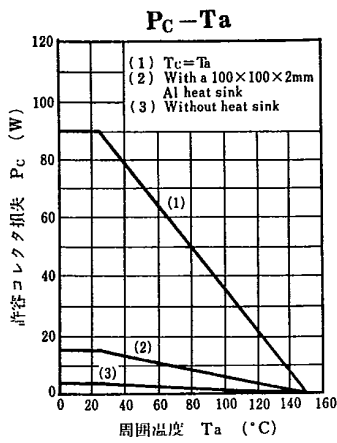


■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =500 V, I _E =0			100	μA
エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5 V, I _C =0			100	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE(sus)}	I _C =0.2 A, L=25 mH	400			V
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =5 V, I _C =0.1 A	15			
	h _{FE2}	V _{CE} =5 V, I _C =3 A	8			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =3 A, I _B =0.6 A			1	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =3 A, I _B =0.6 A			1.5	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =10 V, I _C =0.5 A		11		MHz
ターンオン時間	t _{on}	I _C =3 A, I _B =-I _{B2} =0.6 A			1	μs
蓄積時間	t _{stg}				3	μs
下降時間	t _f				1	μs

トランジスタ

T-33-13 2SC2415



トランジスタ

2SC2480

2SC2480

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

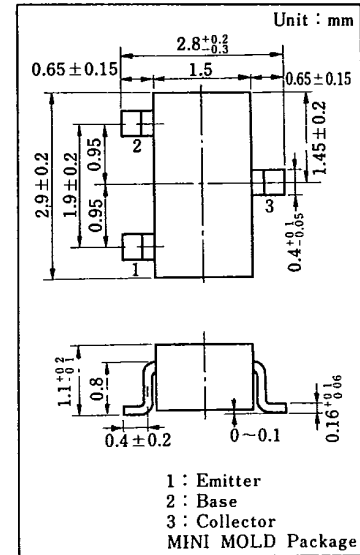
高周波増幅・発振・混合用 / RF Amplifier, Oscillation, Mixer

■ 特徴 / Feature

- トランジション周波数 f_T が高い。 / High f_T

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	3	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	100	mW
接合部温度	T_J	125	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 100 \mu A, I_E = 0$	30			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10 \mu A, I_C = 0$	3			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 2 mA$	25			
トランジション周波数	f_T^*	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 15 mA$	600	1200	1600	MHz
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 2 mA$		0.72		V
掃選容量	C_{re}	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 1 mA, f = 10.7 MHz$		1		pF
電力利得	PG	$V_{CB} = 10 V, -I_E = 1 mA, f = 100 MHz$		20		dB

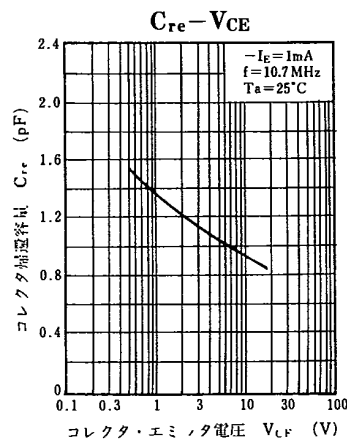
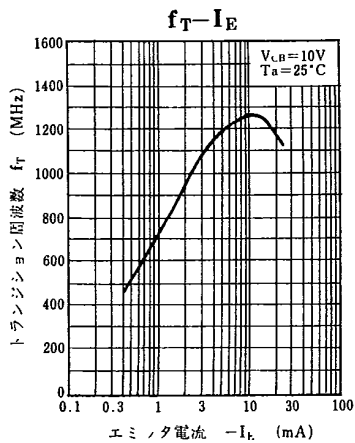
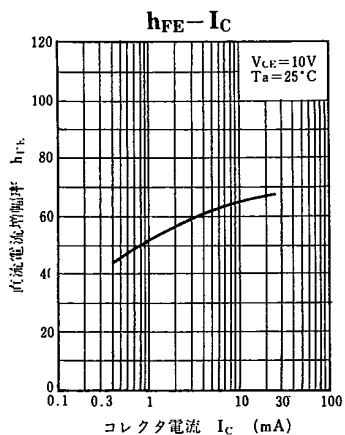
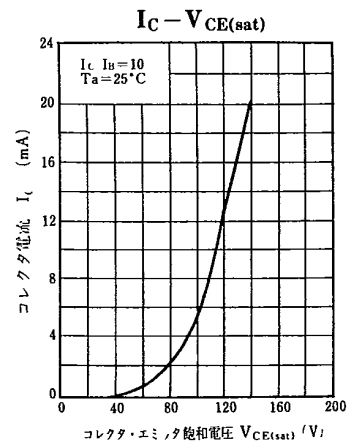
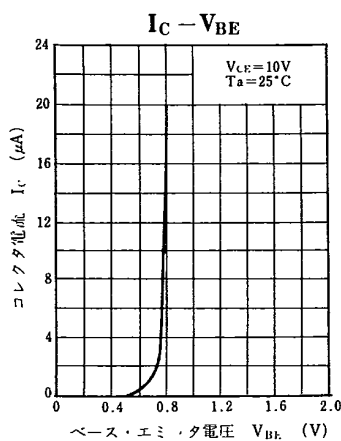
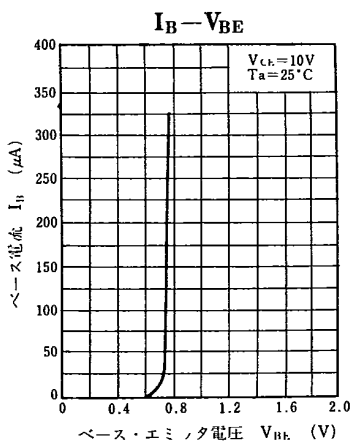
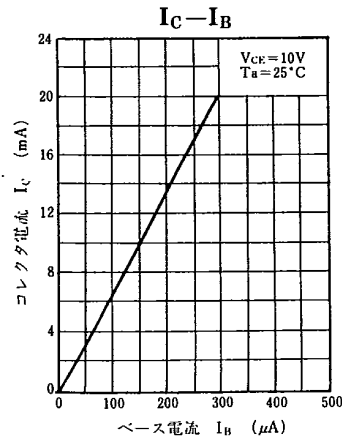
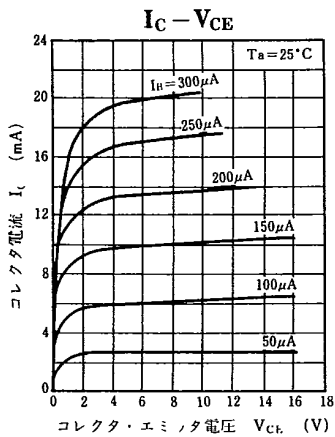
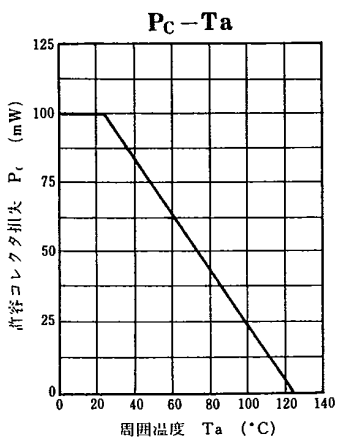
* f_T ランク分類 / f_T Classifications

Class	T	S
f_T (MHz)	600 ~ 1300	900 ~ 1600
Marking Symbol	RT	RS

トランジスタ

T-31-15

2SC2480



トランジスタ

T-31-15

2SC2480

